CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON

presentate il 7 marzo 1990 *

Signor Presidente,
Signori Giudici,

1. Il Tribunal d'instance di Le Mans ha sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali concernenti la classificazione tariffaria dei dischi di silicio.

2. La società Powerex importa dagli Stati Uniti d'America dal 1967 dischi di silicio che, dopo varie operazioni sulle quali avrò occasione di soffermarmi, essa trasforma in dispositivi a semiconduttore, la cui proprietà essenziale è quella di lasciar passare la corrente elettrica in un unico senso.

3. Fino al 1981 la Powerex ha dichiarato questi merci nella sottovoce 85.21 E della Tariffa doganale comune, come parti staccate, con la conseguente applicazione di un dazio doganale del 5,8%. Nel 1981 l'amministrazione doganale francese ha ritenuto che le merci di cui si tratta rientrassero nella sottovoce 85.21 D II, ossia: « diodi, transitori e simili dispositivi a semiconduttori », per la quale è prevista un'aliquota pari al 17%.

4. La controversia tra la Powerex e le dogane francesi ha dato luogo a tre procedimenti giudiziari. Il primo trae origine da un'ingiunzione di pagamento, datata 28 marzo 1983, con la quale le dogane hanno preteso da questa società il pagamento di 2 798 663 FF per le importazioni effettuate dall'8 dicembre 1980. La Powerex ha presentato opposizione all'ingiunzione ed ha adito il Tribunal d'instance di Le Mans. Questo procedimento si è concluso il 23 novembre 1984 con una sentenza definitiva dello stesso tribunale di annullamento dell'ingiunzione e di classificazione delle merci controverse nella sottovoce 85.21 E.

5. Mentre questo procedimento era pendente, la Powerex aveva presentato dichiarazione in dogana secondo la voce tariffaria indicata dalle dogane, trovandosi quindi, in seguito alla sentenza emessa il 23 novembre 1984, ad aver pagato più del dovuto. Conseguentemente essa ha adito, l'11 luglio 1985, lo stesso tribunale con un'azione di ripetizione dell'indebito, diretta ad ottenere il rimborso di un importo pari a 3 085 754 FF. L'amministrazione doganale ha fatto valere in quella sede l'esistenza di un progetto di regolamento comunitario con cui i dischi di silicio sottoposti ad una diffusione selettiva venivano classificati nella sottovoce 85.21 D II. Il Tribunal d'instance di Le Mans, con sentenza 17 ottobre 1986, ha respinto tale mezzo e ha accolto la domanda della Powerex. L'amministrazione doganale ha interposto appello, ma la decisione è stata confermata per l'essenziale con sentenza 9 novembre 1987 della Cour d'appel di Angers. Il 18 luglio 1989 la Cour de cassation ha respinto il ricorso proposto avverso questa sentenza.

6. Il terzo procedimento è stato promosso il 4 novembre 1987 dall'amministrazione doganale, la quale, rivolgendosi al Tribunal d'instance di Le Mans, ha preteso il pagamento di una somma pari a 1 750 287 FF, fondandosi essenzialmente sul regolamento adottato dalla Commissione il 23 aprile 1986, n. 1203, relativo alla classificazione

* Lingua originale: il francese.

delle merci nella sottovoce 85.21 D II della Tariffa doganale comune [1]. Dinanzi al Tribunal d'instance, la Powerex ha sostenuto che le merci da essa importate esulavano dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1203/86 e inoltre che quest'ultimo regolamento era invalido.

7. Il Tribunal d'instance di Le Mans vi ha quindi sottoposto una serie di questioni pregiudiziali per ottenere in sostanza che la Corte si pronunci sull'*interpretazione* del regolamento n. 1203/86, onde stabilire se questo si applichi agli articoli importati dalla Powerex e, in caso affermativo, sulla *validità* dello stesso regolamento nonché sulle *conseguenze temporali* di un'eventuale invalidità.

8. È utile ricordare, per la soluzione della prima questione, il processo di fabbricazione dei dispositivi a semiconduttore della società Powerex come è descritto nella relazione del sig. Camus, consulente tecnico nominato dal Tribunal d'instance di Le Mans con decisione 7 settembre 1988.

9. L'atomo di silicio presenta la particolarità di avere quattro elettroni sul suo strato periferico. La conglomerazione di più atomi permette di ottenere un cristallo puro, nel qual caso ciascun atomo ha in comune otto elettroni sul suo strato periferico con quattro atomi limitrofi. Tutti gli elettroni sono allora perfettamente stabili. Poiché la corrente elettrica è un flusso di elettroni, per ottenere una corrente elettrica in un solo senso occorre iniettare in alcune parti del silicio atomi di fosforo o di arsenico in numero infinitesimale (che la relazione del consulente tecnico definisce « tracce di impurità » o « droganti »), aventi cinque elettroni sul loro strato periferico, e in altre atomi di boro, gallio o alluminio, aventi tre elettroni sul loro strato periferico. Le prime parti di silicio sono denominate N, vale a dire negativo, perché contenenti un eccesso di elettroni, che sono cariche negative; le seconde sono denominate P, ossia positivo, in quanto subiscono una mancanza di elettroni. In uno stesso disco di silicio, si possono creare regioni del tipo N e regioni del tipo P (le une e le altre definite « discrete »). Si produce un leggero spostamento di elettroni da N verso P, ma ormai la corrente potrà passare in un solo senso. Tra le due regioni N e P si trova una zona neutra la quale, sottoposta ad un bombardamento di elettroni, può spostarsi verso la zona N, per garantire una maggiore affidabilità del passaggio della corrente in un unico senso.

10. Esistono due metodi per iniettare « tracce di impurità » o « droganti » nel silicio e ciò, come si vedrà in seguito, è di grande importanza. Il primo e più antico metodo è la diffusione termica. Essa presuppone una temperatura elevata (intorno ai 1 100 — 1 200 °C). Il secondo metodo, più efficiente, consiste nel bombardare il silicio di elettroni a fortissima velocità (irradiazione con fasci di elettroni), i quali creano « lacune » del disco di silicio, il cui effetto elettrico è equivalente a quello di un drogaggio mediante una piccola quantità di impurità. Tuttavia tale procedimento permette di controllare con precisione l'energia e il flusso degli elettroni e quindi di dosare perfettamente l'effetto del drogaggio, cosa impossibile con la sola diffusione termica. L'irradiazione con fasci di elettroni viene effettuata in Francia esclusivamente dalla società Oris Industrie, affiliata del Commissariat à l'énérgie atomique, in Saclay, in quanto essa richiede l'utilizzazione di un acceleratore di particelle.

1 — GU L 108, pag. 20.

11. La relazione del consulente tecnico nominato dal giudice distingue due tipi di pezzi importati dalla società Powerex a seconda del loro grado di lavorazione. I pezzi del tipo A sono meno elaborati di quelli del tipo B e devono pertanto essere introdotti « a monte » nel processo di fabbricazione.

12. Più esattamente, i pezzi del tipo A e del tipo B sono stati sottoposti negli Stati Uniti ad una diffusione termica diretta alla creazione delle zone P e N. Ad essi è stato altresì applicato un supporto di molibdeno per assicurare al disco di silicio una maggiore rigidità ed un migliore contatto elettrico. I pezzi del tipo B presentano inoltre una smussatura, ossia una levigatura della superficie del disco di silicio e il suo rivestimento in vernice isolante, anch'esso totalmente effettuato negli Stati Uniti. Per contro, sui pezzi del tipo A devono ancora essere effettuate successivamente alla loro importazione talune operazioni, e in particolare un trattamento chimico diretto a completare la realizzazione della smussatura nonché l'applicazione della vernice di protezione. Sia i pezzi del tipo A sia quelli del tipo B, dopo la loro importazione in Francia, devono ancora subire un'irradiazione con fasci di elettroni per dosare le proprietà elettriche del silicio. Questa operazione viene commissionata alla società Oris Industrie. Secondo il consulente tecnico, si tratta di una tappa fondamentale nella trafila che richiede specialissimi strumenti.

13. Successivamente, è necessario effettuare un'operazione detta di montaggio o incapsulamento del disco in modo da garantire una sicurezza perfetta, specie all'apparecchiatura che lo circonderà, dato che questo disco verrà attraversato da correnti elettriche di varie migliaia di ampère. Per questa operazione sono necessari un apposito locale denominato « sala bianca », per eliminare la polvere, e una serie di operazioni specifiche che procurano al prodotto un consistente valore aggiunto. Essa viene effettuata presso lo stabilimento Powerex di Le Mans. A quanto sembra, è quest'ultima operazione che il regolamento n. 1203/86, adottato in base alle indicazioni delle dogane francesi, prevede nel suo quarto « considerando » a proposito dei dischi ancora « sprovvisti della scatola e delle connessioni ».

14. Vediamo ora quanto in proposito dispone il suddetto regolamento. L'art. 1 classifica nella sottovoce 85.21 D II i « dischi di silicio, sottoposti ad una diffusione selettiva in modo da creare delle regioni discrete, fissati ad un supporto di molibdeno ». Il quarto « considerando » precisa che questi dischi « anche se sprovvisti della scatola e delle connessioni, costituiscono già dispositivi a semiconduttori ».

15. Una prima difficoltà appare insita nel concetto di « diffusione selettiva ». Infatti, o lo si interpreta nel senso che esso riguarda unicamente la diffusione termica ad esclusione dell'irradiazione con fasci di elettroni, nel qual caso i pezzi importati dalla Powerex hanno senz'altro subito una diffusione selettiva anteriormente alla loro importazione e perciò rientrano incontestabilmente nella sfera di applicazione del regolamento n. 1203/86, o si ritiene, viceversa, che questo concetto riguardi qualsiasi procedimento con cui si creano regioni discrete, *ossia* tanto la diffusione termica quanto l'irradiazione con fasci di elettroni; in quest'ultima ipotesi, ci si può chiedere se i pezzi importati dalla Powerex effettivamente rientrino nell'ambito d'applicazione del regolamento, venendo effettuata la loro irradiazione posteriormente alla loro importazione.

16. Di conseguenza occorre stabilire come debba intendersi la nozione di diffusione selettiva. Certamente, se ci si richiama ai documenti allegati alla perizia effettuata il 12

febbraio 1988 dal sig. Gaussens su richiesta della Powerex, e in particolare al documento n. 1 in lingua inglese[2], risulta che il termine « diffusione » indica, nel linguaggio scientifico, soltanto la diffusione termica[3]. Tuttavia la Commissione ha adottato, il 3 febbraio 1989, il regolamento (CEE) n. 288/89, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati[4], il cui terzo « considerando » precisa che « in tale contesto, la diffusione è definita come l'operazione consistente nella realizzazione di un circuito integrato su un substrato semiconduttore mediante l'applicazione selettiva di apposite sostanze agenti (dopant) ». Se si accoglie questa definizione, anche l'irradiazione con fasci di elettroni rientra nella diffusione avendo essa ad oggetto l'« applicazione selettiva di apposite sostanze agenti (dopant) ». Ora, a prescindere dalle indicazioni fornite al riguardo dal linguaggio scientifico, mi sembra inopportuno fare risultare due definizioni divergenti della diffusione in due settori estremamente affini, quello dei circuiti integrati di cui al regolamento n. 288/89 e quello dei dispositivi a semiconduttore di cui al regolamento n. 1203/86. Benché la definizione della diffusione sia stata fornita solo nella motivazione di un regolamento successivo al regolamento n. 1203/86, quest'ultimo regolamento va a mio parere interpretato alla luce di quella definizione.

17. Pertanto la nozione di diffusione selettiva deve a mio giudizio ricomprendere *al contempo* la diffusione termica e l'irradiazione con fasci di elettroni. Può tuttavia desumersi da tale circostanza che i pezzi importati dalla Powerex, non *ancora* sottoposti a tale irradiazione, non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1203/86? A mio parere la risposta è negativa. Questi pezzi, infatti, sono stati sottoposti ad una diffusione termica negli Stati Uniti ed è pacifico tra le parti che la diffusione termica sia un metodo di diffusione selettiva. Ne consegue che il fatto che essi debbano *ancora* essere sottoposti ad un'*ulteriore* operazione di diffusione selettiva, quella mediante irradiazione, al fine di realizzare completamente il passaggio in un senso della corrente e la resistenza nell'altro senso, non significa che si possa ritenere che essi non abbiano subito *nessuna* diffusione selettiva. Alla lettera, questi pezzi del tipo A o del tipo B, sono pur stati sottoposti prima della loro importazione ad una diffusione selettiva in modo da creare regioni discrete. Conseguentemente essi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1203/86 e propongo che la Corte risolva la prima questione in questo senso.

18. Occorre quindi esaminare la questione relativa alla validità del regolamento controverso. La Powerex muove due censure nei suoi confronti: in primo luogo, esso sarebbe stato adottato sulla scorta di dati di base erronei, essendo inesatta l'asserzione secondo cui ai dischi di silicio mancherebbe solo di essere muniti di una scatola e di connessioni per costituire, senza che occorra altro, dispositivi a semiconduttore; in secondo luogo, la Commissione avrebbe commesso eccesso di potere classificando i dischi di silicio di cui trattasi in una voce tariffaria inammissibile, alla luce dei criteri interpretativi della nomenclatura.

19. Corrisponde senz'altro al vero, come si è già avuto occasione di rilevare richiamando le conclusioni della relazione del consulente tecnico sig. Camus, che i dischi di silicio, dopo essere stati sottoposti ad una diffusione selettiva e fissati ad un supporto di molibdeno, non devono semplicemente essere muniti di una scatola e di connessioni, ma devono ancora subire un'ulteriore diffusione selettiva, quella mediante irradiazione. Deve ricordarsi ora il quarto « considerando » del regolamento controverso, secondo il quale « i dischi sopra descritti, an-

2 — C. K. Chu e J. F. Donlon: « Annealing effects on electron irradiated and gold diffused thyristors for fast switch application ».

3 — Ad esempio: « Fast switch diodes and thyristors can be made by either electron irradiation or gold diffusion » (« I diodi a interruttore fisso possono essere realizzati sia mediante irradiazione con elettroni sia mediante diffusione aurea »).

4 — GU L 33, pag. 23.

che se sprovvisti della scatola e delle connessioni, costituiscono già dispositivi a semiconduttori ». Tale considerando mi pare criticabile per due motivi: innanzitutto, perché sembra presupporre che debbano essere ancora realizzate soltanto operazioni di connessione e di assemblaggio, il che è inesatto, ma soprattutto in quanto esso afferma che i dischi che hanno subito una diffusione selettiva costituiscono « già » dispositivi a semiconduttori. La Commissione ha infatti applicato in questo caso la regola generale n. 2, lett. a), per l'interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, che prevede che « qualsiasi riferimento ad un articolo in una voce determinata della tariffa riguarda tale articolo anche se incompleto o non finito a condizione che esso già presenti le caratteristiche essenziali dell'articolo completo o finito ». Ne consegue che il regolamento ha optato per una loro classificazione nella sottovoce 85.21 D II in considerazione del fatto che dal momento in cui sono stati sottoposti ad una diffusione termica i dischi di silicio presentano le caratteristiche essenziali di un dispositivo a semiconduttore. Ritengo perciò che il nocciolo del problema risieda principalmente nella questione di stabilire quale sia la caratteristica essenziale di un dispositivo a semiconduttori e se i dischi importati dalla Powerex presentino o meno una siffatta caratteristica.

20. Qual è ora la caratteristica essenziale di un dispositivo a semiconduttori? Secondo la relazione del consulente tecnico nominato in giudizio, « i pezzi del tipo A posseggono già una struttura di tiristore (a più giunzioni del tipo PNPN) ed è possibile farli funzionare " su un piano " come un tiristore applicando tensioni appropriate su anodo, catodo e grilletto ». Va da sé che questi pezzi sono ancora inutilizzabili in questo stato. Come il sig. Gaussens ha dichiarato durante la fase orale, senza essere smentito, l'utilizzazione di questi pezzi nello stato in cui si trovano provocherebbe dei cortocircuiti. Ci si chiede, di conseguenza, se la caratteristica essenziale di un dispositivo a semiconduttori debba ritenersi quella di lasciar passare la corrente in un unico senso, sia pure in modo grossolano e inutilizzabile, oppure quella di lasciar passare la corrente in un solo senso in modo perfetto, consentendo il pieno controllo dei flussi elettrici e della loro intensità. La risposta, a mio parere, è immediata, ed è necessariamente la seconda soluzione. La caratteristica essenziale non si restringe infatti, a mio avviso, ad una semplice « attitudine »; essa deve tener conto dell'esistenza o meno delle principali capacità di funzionamento normalmente richieste. Quando la regola generale n. 2, lett. a), per l'interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune fa riferimento agli articoli incompleti o non finiti, si riferisce ad operazioni di finizione, di assemblaggio, forse anche a qualche operazione un po' più complessa, non certo però ad un'operazione estremamente sofisticata e ad alto valore aggiunto come l'irradiazione con fasci di elettroni mediante il passaggio dei pezzi in un acceleratore di particelle, unica operazione idonea ad evitare cortocircuiti. Tale opinione trova conferma nel quarto « considerando » del summenzionato regolamento n. 288/89, in cui si precisa che la diffusione contribuisce a dotare il circuito integrato di *tutte* le capacità funzionali necessarie. Applicando questa definizione nel caso di specie, si può solo osservare che i dischi di silicio, dopo la loro importazione, non sono ancora muniti di tutte le loro capacità funzionali dal momento che essi, nello stato in cui si trovano, sono inutilizzabili e permettono il passaggio della corrente elettrica in un unico senso solo in condizioni per così dire « di laboratorio ».

21. Occorre d'altra parte rilevare, se ce ne fosse bisogno, che il regolamento n. 1203/86, in quanto risulta considerare che i dischi di silicio dopo la loro importa-

zione devono soltanto essere ancora muniti di scatola e di connessioni, sembra riferirsi ad operazioni di assemblaggio a carattere semplice, alla portata di qualsiasi dettagliante, mentre è noto che le operazioni cui devono ancora essere sottoposti i dischi importati dalla Powerex sono particolarmente sofisticate, in particolare per il fatto che esse devono essere effettuate nella sala bianca e perché procurano agli articoli un notevole valore aggiunto.

22. Ora, la Corte non si è pronunciata, per quanto è di mia conoscenza, sulla natura stessa dell'assemblaggio alla luce della Tariffa doganale comune [5] ma potrei forse ricordare che in un settore limitrofo, quello dell'origine delle merci, la Corte ha avuto occasione di precisare in una recente sentenza che

« si devono considerare come semplici operazioni di montaggio le operazioni che non richiedono personale dotato di particolare specializzazione per i lavori in questione, né un'apparecchiatura perfezionata, né impianti specialmente attrezzati per il montaggio. Siffatte operazioni non appaiono infatti idonee a contribuire a fornire alla merce in questione le sue caratteristiche o proprietà essenziali » [6].

In quella stessa sentenza voi avete ammesso il ricorso al criterio sussidiario del valore aggiunto dal montaggio. A mio parere, nei limiti in cui tale giurisprudenza possa essere trasferita al caso in esame, la complessità delle operazioni di montaggio necessarie nella fattispecie [7] milita del pari in favore della classificazione dei dischi di silicio nella sottovoce relativa ai pezzi staccati e non a quella dei dispositivi a semiconduttore.

23. Sembra così, per concludere su questo punto, che fatta salva la complessità delle operazioni di montaggio, soltanto i dischi di silicio che siano stati sottoposti ad una diffusione selettiva, non solo termica, ma altresì mediante irradiazione con fasci di elettroni, acquisendo così la proprietà di lasciar passare la corrente in un unico senso e in modo completo, possono essere ricondotti alla sottovoce relativa ai dispositivi a semiconduttore. Non è questo il caso dei dischi importati dalla Powerex. Il regolamento controverso, riferendosi genericamente nel suo art. 1 ai dischi di silicio sottoposti ad una diffusione selettiva ed applicandosi conseguentemente a dischi che non costituiscono nello stato in cui si trovano dispositivi a semiconduttori, deve ritenersi invalido. Propongo che la Corte si pronunci sulla seconda questione in questo senso.

24. La terza questione sottoposta dal giudice a quo verte sull'effetto di tale invalidità sulle importazioni realizzate anteriormente alla sentenza che pronuncerà la Corte. Trattasi di un problema classico. Nella prima sentenza Roquette [8], la Corte ha dichiarato applicabili per analogia ai procedimenti su rinvio pregiudiziale le disposizioni dell'art. 174, secondo comma, del Trattato CEE, secondo cui, in un ricorso per annullamento, spetta alla Corte stessa precisare « gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi ». La limitazione degli effetti, e in particolare la limita-

5 — Tranne forse nella sentenza 29 maggio 1979, IMCO (causa 165/78, Racc. pag. 1837), che tuttavia non soccorre nel presente caso.

6 — Sentenza 13 dicembre 1989, Brother International GmbH, punto 17 della motivazione (causa C-26/88, Racc. 1989, pag. 4253).

7 — V. nota precedente, punto 12 della motivazione.

8 — Sentenza 15 ottobre 1980, Roquette (causa 145/79, Racc. pag. 2917); v. anche le sentenze 15 ottobre 1980, Société Maïseries de Beauce (causa 109/79, Racc. pag. 2883), sentenza 15 ottobre 1980, Société Providence agricole (causa 4/79, Racc. pag. 2823); sentenza 15 gennaio 1986, Pinna (causa 41/84, Racc. pag. 1); sentenza 27 febbraio 1985, Société des produits de maïs (causa 112/82, Racc. pag. 719); sentenza 22 maggio 1985, Fragd (causa 33/84, Racc. pag. 1605).

zione nel tempo, tuttavia non è se non un'eccezione alla regola che li riconduce alla data dell'atto impugnato dichiarato « nullo e inesistente ». Come tutte le eccezioni, essa deve essere interpretata restrittivamente e la sua portata limitata alle esigenze che ne costituiscono fondamento, ossia, secondo la vostra giurisprudenza, a quelle della certezza del diritto. Orbene, poiché il regolamento controverso si applica, a quanto sembra, soltanto alle importazioni della società Powerex, non v'è motivo di certezza del diritto che sembri condurre ad una limitazione degli effetti della declaratoria di invalidità. È in tale senso che suggerisco di risolvere la terza questione.

25. In definitiva, propongo che la Corte si pronunci come segue:

« 1) Il regolamento (CEE) della Commissione 23 aprile 1986, n. 1203, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 85.21 D II della Tariffa doganale comune deve essere interpretato nel senso che esso si applica a dischi di silicio sottoposti ad una diffusione selettiva mediante diffusione termica, fissati su un supporto di molibdeno, anche se essi devono ancora subire, dopo la loro importazione nella Comunità, tra le altre operazioni, una diffusione selettiva mediante irradiazione con fasci di elettroni.

2) Il summenzionato regolamento è invalido nella parte in cui classifica nella sottovoce 85.21 D II della Tariffa doganale comune i dischi di silicio che non presentano, nello stato in cui si trovano al momento della loro importazione, le caratteristiche essenziali dei dispositivi a semiconduttore.

3) Gli effetti di questa invalidità non devono essere limitati ».